



	<h2 style="color: #D9534F;">SI3529DV-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI3529DV-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 40V 2.5A 6-TSOP
	Datenblätter:  SI3529DV-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3529DV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 40V 2.5A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 40V 2.5A, 1.95A 1.4W
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.4W
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A, 1.95A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 2.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	205pF @ 20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)


SI3529DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3529DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3529DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3529DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3552DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 6-TSOP</p>	 <p>SI3529DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 40V 2.5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3529DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N/P-CH 40V 2.5A 6-TSOP</p>	 <p>SI3529DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 40V 2.5A 6-TSOP</p>
 <p>SI3552DV-T1 VISHAY SI3552DV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3522V SANKEN SI3522V SANKEN</p>	 <p>SI3552DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 6TSOP</p>	 <p>SI3500-A-GMR Energy Micro (Silicon Labs) IC REG BUCK ADJ 0.4A 20QFN</p>

heiße Teile

Mehr

 SI3483DV-T1-GE3	 SI3493BDV-T1-E3	 SI3493BDV-T1-E3	 SI3493BDV-T1-E3-S	 SI3493BDV-T1-GE3
 SI3493BDV-T1-GE3	 SI3493DDV-T1-GE3	 SI3493DDV-T1-GE3	 SI3493DV	 SI3493DV-T1
 SI3493DV-T1-E3	 SI3493DV-T1-E3	 SI3493DV-T1-E3	 SI3493DV-T1-GE3	 SI3493DV-T1-GE3
 SI3495DV	 SI3495DV-T1-E3	 SI3495DV-T1-E3	 SI3495DV-T1-GE3	 SI3495DV-T1-GE3
 SI3499DV-T1-E3	 SI3499DV-T1-E3	 SI3499DV-T1-GE3	 SI3499DV-T1-GE3	 SI3500-A-GM
 SI3529DV-T1-GE3	 SI3552DV	 SI3552DV-T1	 SI3552DV-T1-E3	 SI3552DV-T1-E3
 SI3552DV-T1-GE3	 SI3552DV-T1-GE3	 SI3585CDV	 SI3585CDV-T1-GE3	 SI3585CDV-T1-GE3
 SI3585DV	 SI3585DV-T1	 SI3585DV-T1-E3	 SI3585DV-T1-E3	 SI3585DV-T1-GE3
 SI3585DV-T1-GE3	 SI3586DS-T1-E3	 SI3586DV	 SI3586DV-T1-E3	 SI3586DV-T1-E3
 SI3586DV-T1-GE3	 SI3586DV-T1-GE3	 SI3588DV	 SI3588DV-T1-E3	 SI3588DV-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited